

**N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET**

**SIF8N100B**

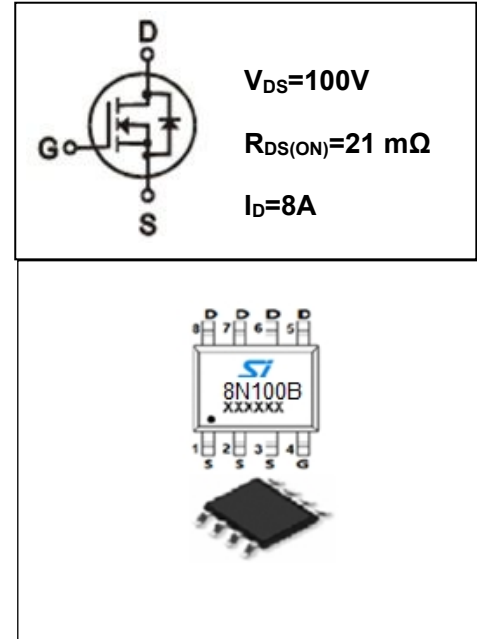
- 特点：热阻低 导通电阻低 栅极电荷低，开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范
- FEATURES: ■LOW THERMAL RESISTANCE ■LOW  $R_{DS(ON)}$  TO MINIMIZE CONDUCTIVE LOSS ■LOW GATE CHARGE FOR FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE ■RoHS COMPLIANT
- 应用：低压高频逆变电路 同步整流 开关应用
- APPLICATION: ■LOW VOLTAGE,HIGH FREQUENCY INVERTERS ■SYNCHRONOUS RECTIFICATION ■SWITCH APPLICATIONS

●最大额定值 (TC=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

SOP-8

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	$V_{DS}$	100	V
栅-源电压 gate-source Voltage	$V_{GS}$	±20	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C ①	$I_D$	8	A
耗散功率 Total Power Dissipation ①	$P_{tot}$	2.1	W
最高结温 Junction Temperature	$T_j$	150	°C
存储温度 Storage Temperature	$T_{STG}$	-55-175	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	$E_{AS}$	23	mJ



●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	100			V
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$ ③	1.0		3.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	$I_{DSS}$	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$			1	$\mu A$
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ( $V_{DS}=0$ )	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 20V$			±100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=8A$ ③		21	25	mΩ
		$V_{GS}=4.5V, I_D=6A$ ③		22	27	
跨导 Forward Transconductance	$g_{FS}$	$V_{DS}=10V, I_D=8A$ ③		22		S

●订单信息/ORDERING INFORMATION:

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料/ Normal Package Material	无卤塑封料/Halogen Free
SOP-8 条管装/TUBE PACKING	SIF8N100B SOP-8-TU	SIF8N100B SOP-8-TU-HF
SOP-8 编带装/TAPE & REEL PACKING	SIF8N100B SOP-8-TR	SIF8N100B SOP-8-TR-HF

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF8N100B

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
输入电容 Input Capacitance	Ciss	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 15V$ $F = 1.0MHz$		4400		pF
输出电容 Output Capacitance	Coss			185		
反向传输电容 Reverse Transfer Capacitance	Crss			140		
导通延迟 Turn -On Delay Time	Td(on)			13		ns
开启上升时间 Turn -On Rise Time	$T_r$	$V_{DD}=30V, I_D=8A$ $V_{GS} = 10V, R_{GEN}=3\Omega$		11		ns
关断延迟 Turn -Off Delay Time	Td(off)			52		ns
关断下降时间 Turn -Off Fall Time	$T_f$			10		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	Qg			89		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Qgs	$I_D = 15A, V_{DS} = 80V$ $V_{GS} = 10V$		11		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Qgd			25		nC
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	$V_{SD}$	$T_j=25^\circ C, I_F=8A$ $V_{GS} = 0V$ ③		0.8	1.2	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	trr	$I_f=8A, di/dt=100A/\mu s$		33		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Qrr	$T_j=25^\circ C, \text{③}$		54		nC

●热特性

●Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	RthJC			59.5	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	RthJA			75	$^\circ C/W$

注释(Notes):

- ① 以最高结温为限制，  $T_c=25^\circ C$ 时测试。  
 $I_D$  &  $P_D$  base on maximum allowable junction temperature, test at  $T_c=25^\circ C$ .
- ② 初始结温= $25^\circ C$ ,  $L=0.1mH$ .  
Starting  $T_j=25^\circ C, L=0.1mH$
- ③ 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$  , 占空比 $\leq 2\%$   
Pulse Test : Pulse width  $\leq 300\mu s$ , Duty cycle  $\leq 2\%$

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF8N100B

● 特性曲线

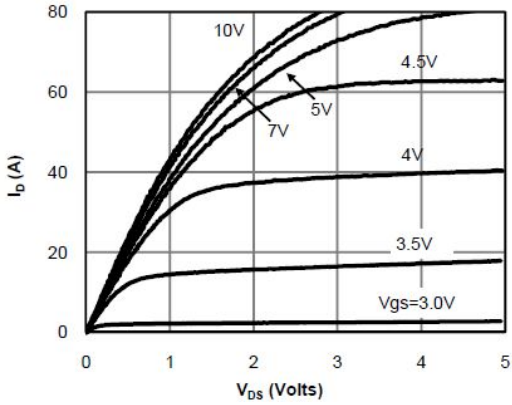


Figure 1 Output Characteristic

图 1 输出特性曲线,  $T_c=25^\circ\text{C}$

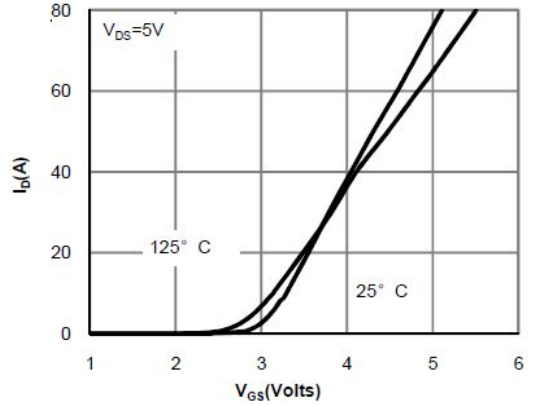


Figure 2 Transfer Characteristic

图 2 转移特性曲线

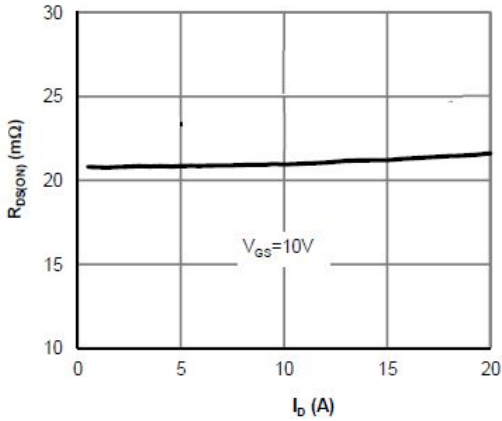


Figure 3  $R_{ds(on)}$ -Drain Current

图 3 导通电阻与漏极电流 曲线

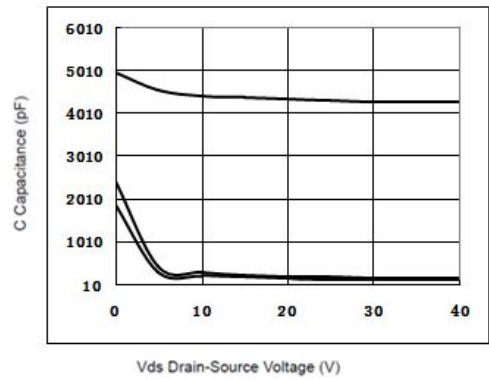


Figure 4 Capacitance characteristic

图 4 电容 曲线

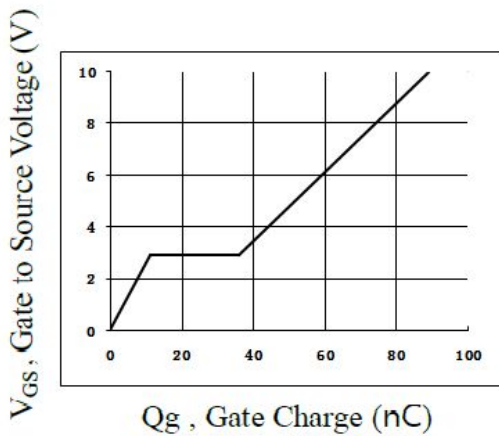


Figure 5 Gate Charge

图 5 栅电荷 曲线

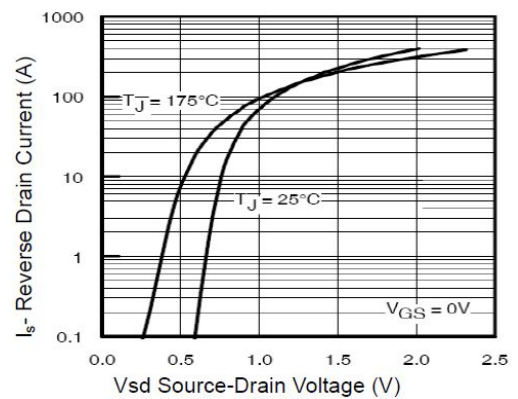


Figure 6 Source-Drain Diode Forward

图 6.二极管正向压降与源极电流 曲线

## SOP8 封装机械尺寸 SOP8 MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.80		5.10	C	1.30		1.50
A1	0.37		0.47	C1	0.55		0.75
A2		1.27 TYP		C2	0.55		0.65
A3		0.41 TYP		C3	0.05		0.20
B	5.80		6.20	C4	0.19	0.20TYP	0.23
B1	3.80		4.00	D		1.05TYP	
B2		5.0TYP		D1	0.40		0.62

